



Toshiba estende ulteriormente la gamma di MOSFET a supergiunzione con quattro ulteriori dispositivi da 650V

Le prestazioni migliorate e le perdite ridotte aumenteranno l'efficienza degli alimentatori

Düsseldorf, Germania, 5 Aprile 2022 – Toshiba Electronics Europe GmbH ("Toshiba") ha aggiunto altri quattro dispositivi MOSFET di potenza a supergiunzione a canale N da 650V per estendere la propria serie DTMOSVI. I nuovi dispositivi fanno seguito al successo di mercato dei dispositivi attuali e saranno utilizzati principalmente in applicazioni quali l'alimentazione in campo industriale e per l'illuminazione e altre applicazioni in cui è richiesta la massima efficienza con un fattore di forma ridotto.

I nuovi MOSFET TK090E65Z, TK110E65Z, TK155E65Z e TK190E65Z consentono di ottenere una riduzione del 40% rispetto alla generazione precedente di DTMOS della figura di merito (FoM) del prodotto resistenza di on al drain-source ($R_{DS(on)}$) x carica al gate-drain (Q_{gd}). Ciò si tradurrà in una sostanziale diminuzione delle perdite di commutazione rispetto ai dispositivi precedenti. Di conseguenza, i progetti che incorporano i nuovi dispositivi osserveranno un aumento di efficienza. Il miglioramento delle prestazioni interesserà sia i nuovi progetti che agli aggiornamenti dei progetti esistenti.

Tutti e quattro i nuovi dispositivi offrono una tensione al drain-source (V_{DSS}) di 650V con una capacità di corrente di drain (I_D) fino a 30A. La resistenza di on al drain-source ($R_{DS(on)}$) è di appena $0,09\Omega$ e la carica di gate-drain la carica (Q_{gd}) è di soli $7,1nC$, consentendo il funzionamento con basse perdite alle alte velocità. Tutti i dispositivi sono alloggiati in package standard TO-220 a foro passante.

Toshiba continuerà ad espandere la propria linea di prodotti per rispondere alle tendenze del mercato e per contribuire a migliorare l'efficienza degli alimentatori e dei sistemi.

Per ulteriori informazioni, visitare: [https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/mosfets/400v-900v-mosfets/articles/state-of-the-art-super-junction-mosfet -dtmos6.html](https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/mosfets/400v-900v-mosfets/articles/state-of-the-art-super-junction-mosfet-dtmos6.html)

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre alle unità HDD, il vasto portafoglio di prodotti della società comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi a discreti che vanno dai diodi ai circuiti integrati logici, ai semiconduttori ottici, oltre ai microcontrollori e ai prodotti standard specifici per un'applicazione (ASSP), tra gli altri.

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di marketing, vendite e servizi logistici. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki Kumagai.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com.

Indirizzo di riferimento per le pubblicazioni:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197
Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH
Tel: +44 (0)193 282 2832
E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek
Tel: +49 (0) 4181 968098-13
Web: www.publitek.com
E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Aprile 2022

Ref. 7393